

手法	入射	検出	分析面積	検出深さ (検出物)	検出下限 (atmic%概算)	元素	簡便	有機	無機	定性	定量	微量	状態	絶縁
XRD	X線	回折X線	100um～ 10mm ϕ	数十nm (回折X線)	10%	結晶のみ	◎		◎		△		○	◎
XPS	X線	光電子	20um～ 数100um ϕ	数nm (光電子)	1%	Li～		△	◎	○	○		◎	◎
AES	電子	オージェ電子	数+nm ϕ	数nm (オージェ電子)	1%	Li～	○		◎	○	○			△
TEM-EDX	電子	特性X線	数nm ϕ	試料厚依存 (特性X線)	1%	B～			◎	○	○			○
SEM-EDX	電子	特性X線	数um ϕ	数um (特性X線)	1%	B～	◎		◎	○	○			○
XRF	X線	特性X線	10um ϕ 1.2mm ϕ	数um (蛍光X線)	0.01% (0.1wt%)	Na～	◎		◎	○	○	△		◎
SIMS	イオン	二次イオン	20um～ 500um角	数nm (二次イオン)	1ppb	H～			◎	△	◎	◎		
TOF-SIMS	イオン	二次イオン	10um～ 500um角	数原子層 (二次イオン)	1ppm	H～		◎	◎	◎		○	◎	○
FT-IR	光	赤外吸収	50um角	数十um (赤外光)	1%		◎	◎	△	○	△		○	◎
Raman	光	ラマン散乱光	1um ϕ	数十um (ラマン散乱光)	1%		◎	○	○	△			○	◎